

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Phạm Kim Ngọc

2. Ngày tháng năm sinh: 04/04/1982; Nam ☐; Nữ ☒; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☒

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Số 2, ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0945295084;

E-mail: phamkngoc@hcmus.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 11,2006 đến tháng, năm 09,2013: Nghiên cứu viên tại Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Từ tháng, năm 10,2010 đến tháng, năm 10,2011: Sinh viên trao đổi tại Viện công nghệ Toyota, Nhật Bản

Từ tháng, năm 10,2013 đến tháng, năm 06,2022: Giảng viên tại Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Vật liệu Nano và Màng mỏng, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu;

Chức vụ cao nhất đã qua: Không có

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Địa chỉ cơ quan: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

Không có

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 15 tháng 09 năm 2006, số văn bằng: TB 01384/71KH2/2003, ngành: Khoa học vật liệu, chuyên ngành: Vật liệu màng mỏng

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 24 tháng 12 năm 2012, số văn bằng: TM 00256/34KH2/2012, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Được cấp bằng TS [5] ngày 26 tháng 09 năm 2017, số văn bằng: QS 08151/13KH2/2016, ngành: Khoa học Vật liệu, chuyên ngành: N/A

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

Các nghiên cứu chủ yếu của ứng viên tập trung vào tính chất vật lý (tính chất điện, quang, cơ chế truyền dẫn điện tích,...) của các vật liệu có cấu trúc thấp chiều ứng dụng trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu và chuyển đổi năng lượng nhiệt năng thành điện năng.

1. Hướng nghiên cứu 1 (chính): Vật liệu có khả năng lưu trữ dữ liệu ứng dụng trong bộ nhớ điện trở.

2. Hướng nghiên cứu 2 (phụ): Vật liệu ứng dụng trong chuyển hóa năng lượng (nhiệt năng thành điện năng).

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 1 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 3 cấp Bộ;

- Đã công bố (số lượng) 37 bài báo khoa học, trong đó 31 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Chiến sĩ thi đua	Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh	2016
2	Cá nhân có công bố khoa học xuất sắc	Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh	2020
3	Nhà nghiên cứu trẻ	Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh	2022

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Dựa theo các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo được quy định trong Luật giáo dục và luật Khoa học và Công nghệ, ứng viên tự đánh giá như sau:

Ứng viên được đào tạo theo hệ chính qui hệ Đại học và sau đại học tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM), công tác và làm việc trong môi trường giáo dục, nghiên cứu (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM; từ 2007). Có đủ kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng ngoại ngữ (Anh văn) để thực hiện các công việc liên quan đến giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên môn.

a. Nhiệm vụ giảng dạy:

Ứng viên hoàn thành tốt công tác giảng dạy Đại học và Sau đại học, hướng dẫn sinh viên và học viên cao học, thực hiện khóa luận tốt nghiệp Đại học và luận văn Thạc sĩ. Ứng viên đã hướng dẫn thành công 1 Thạc sĩ lĩnh vực Vật lý. Hiện ứng viên đang hướng dẫn 1 học viên cao học ngành Vật lý. Ứng viên đã tham gia biên soạn 01 Sách chuyên khảo được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong chương trình đào tạo bậc Đại học và Sau đại học của Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Ứng viên tham gia công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA bậc Đại học ngành Khoa học Vật liệu thuộc Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

b. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:

Ứng viên là chủ nhiệm và tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó ứng viên đã và đang chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp ĐHQG-HCM (3/4 đã nghiệm thu). Ứng viên và cộng sự đã công bố thành công 37 công trình khoa học gồm 30 quốc tế uy tín, 2 quốc tế và 5 trên các tạp chí khoa học trong nước. Ứng viên tham gia và có báo cáo tại các hội nghị khoa học trong lĩnh vực Vật lý và Khoa học vật liệu.

Từ 30/8/2018, ứng viên đảm nhiệm vai trò Trưởng Bộ môn Vật liệu nano và Màng mỏng, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu. Ở vai trò này, ứng viên đã cập nhật chương trình đào tạo của chuyên ngành vật liệu màng mỏng theo hướng tiếp cận CDIO, liên kết với Trung tâm Vật liệu cấu trúc nano và phân tử (ĐHQG-HCM) giảng dạy các môn thực hành được tiếp cận các phương pháp phân tích hiện đại giúp nâng cao kỹ năng cho sinh viên... Ứng viên đã tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu với doanh nghiệp và cựu sinh viên thành đạt cho sinh viên của Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu (Hyosung, First Solar, M. Technology...) giúp các em có thêm thông tin về ngành học, tiếp cận cơ hội thực tập và việc làm ngay từ năm 3 đại học. Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh viên và công ty Talent Mind tổ chức khóa học tập Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc cho sinh viên năm 4. Tổ chức các buổi webinar chia sẻ thông tin tư vấn du học ở các quốc gia như Pháp, Ý, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc... với khách mời là các Thầy Cô và du học sinh, đã và đang học tập và công tác tại các trường và viện ở nước ngoài.

Ứng viên đã tổ chức và lãnh đạo đơn vị hoạt động trên định hướng hoạt động của nhà trường và Khoa Khoa

học và Công nghệ Vật liệu, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, chuyên môn liên ngành

hướng nghiên cứu thực nghiệm và tính toán mô phỏng, khai thác các trang thiết bị hiện có tại cơ sở và tăng cường hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu. Bộ môn Vật liệu nano và Màng mỏng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2019-2020 của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

c. Các hoạt động chuyên môn khác:

Thành viên hội đồng khoa học - Khoa học và Công nghệ Vật liệu ĐHQG-HCM 2019-2022. Thành viên tổ công tác kiểm định AUN của Khoa học và Công nghệ Vật liệu ĐHQG-HCM.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 14 năm 0 tháng

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2016-2017				2	129.5		129.5/455.92/270
2	2017-2018				3	325.5		325.5/653.7/270
3	2018-2019				4	228.25	22.5	250.75/609.56/216
03 năm học cuối								
4	2019-2020				4	224.5	22.5	247/548.35/216
5	2020-2021			1	3	159.75	22.5	182.25/404.38/216
6	2021-2022				3	229.75	67.5	297.25/413.63/216

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm
- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☐ hoặc TSKH ☐; Tại nước: năm
- b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:
- c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☐:
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):
- d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): TOEIC Listening and Reading: 605

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/ BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVC H/CK 2/BS NT	Chính	Phụ			
1	Trần Thị Hoàng Quyên		X	X		12/2018 đến 12/2021	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM	2022

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phầ n biên soạn (từ tran g ... đến tran g)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
1	Vật liệu màng mỏng ô xít kim loại ứng dụng trong bộ nhớ điện tử	CK	NXB ĐHQG- HCM, năm 2021	3	VC	(Tran g 1 - 118)	855/QĐ-KHTN ngày 28.6.2021 và 857/QĐ-KHTN ngày 28.6.2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/ TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Tổng hợp và khảo sát tính chất trở nhớ của màng mỏng TiO ₂ trên đế dero	CN	Mã số: C2015- 18-17, cấp Bộ	04/04/20 15 đến 04/04/20 16	10/12/2016 - KQ: Tốt
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
2	Chế tạo và khảo sát tính chất đảo điện trở thuận nghịch của cấu trúc trở nhớ sử dụng vật liệu lai hóa nanocomposite vô cơ – hữu cơ	CN	103.02- 2018.67, cấp Bộ	12/12/20 18 đến 12/12/20 20	19/7/2021 - KQ: Đạt
3	Chế tạo và khảo sát linh kiện trở nhớ trong suốt đàn hồi dựa trên nền vật liệu polymer sinh học	CN	C2018- 18-27, cấp Bộ	4/4/2018 đến 4/4/2020	28/4/2021 - KQ: Tốt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (khôn g tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng , năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Electrical Conduction and Resistance Switching Mechanisms of	5	Không	Journal of Institute of Korean Electrical and Electronics Engineers	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		17, 3, 229-233	07/201 3

	Ag/ZnO/Ti Structure							
2	An influence of bottom electrode material on electrical conduction and resistance switching of TiOx thin films	5	Có	European Physics Journal of Applied Physics	Q4 - ISI IF: 0.874	5	64, 03, 30102	12/2013
3	Different Directions of Switching of Chromium Oxide Thin Films	9	Có	Journal of Electronic Materials	Q2 - ISI IF: 1.938	1	43 2747-2753	05/2014
4	Correlation between crystallinity and resistive switching behavior of sputtered WO3 thin films	5	Không	Current Applied Physics	Q2 - ISI IF: 2.48	9	14, 12, 1707-1712	10/2014
5	Study of the Resistive Switching Effect in Chromium Oxide Thin Films by Use of Conductive Atomic Force Microscopy	8	Có	Journal of Electronic Materials	Q2 - ISI IF: 1.938	2	44, 10, 3395-3400	06/2015
6	Understanding electrical conduction states in WO3 thin films applied for resistive random-access memory	5	Không	Journal of Electronic Materials	Q2 - ISI IF: 1.938	2	45, 5, 2423-2432	02/2016
7	TiO2 thin film based	4	Có	Advances in Natural Sciences: Nanoscience	Q2 - ISI IF: 2.307	22	7, 1, 015017	03/2016

	flexible resistive switching random access memory							
8	Surface Mapping of Resistive Switching CrOx Thin Films	5	Có	Advances in Materials Physics and Chemistry	Quốc tế - Scopus	2	6, 3, 21- 27	05/201 6
9	Thermoelectric Properties of Indium and Gallium dually doped ZnO thin films	13	Không	ACS Applied Materials and Interfaces	Q1 - ISI IF: 9.44	52	8, 49, 339916	12/201 6
10	Effect of post- annealing processes on filamentary- based resistive switching mechanism of chromium oxide thin films	8	Có	Journal of Electronic Materials	Q2 - ISI IF: 1.918	2	46, 6, 3265	01/201 7
11	Surface functionalizatio n of WO3 thin films with (3- Aminopropyl) triethoxysilane and succinic anhydride	10	Không	Journal of Electronic Materials	Q2 - ISI IF: 1.938	12	46, 6, 3345- 3352	03/201 7
12	Resistance switching behavior of ZnO thin films for random access memory applications	10	Không	Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Tp.HCM, Quốc gia uy tín ISSN: 1859- 0128			16 81-85	05/201 3
13	Ảnh hưởng của chiều dày lên đặc trưng đảo điện trở thuận nghịch của màng mỏng	3	Có	Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Tp.HCM, Quốc gia uy tín ISSN: 1859- 0128			19 92- 100	03/201 6

14	Chế tạo và khảo sát tính chất của linh kiện trở nhớ trên đế dẻo (PET)	4	Có	Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Tp.HCM, Quốc gia uy tín ISSN: 1859-0128			19, 2, 12-18	06/2016
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
15	Comprehensive resistive switching behavior of hybrid polyvinyl alcohol and TiO ₂ nanotube nanocomposites identified by combining experimental and density functional theory studies	5	Có	Journal of Materials Chemistry C	Q1 - ISI IF: 7.393	20	6 1971-1979	01/2018
16	Effect of annealing temperature on thermoelectric properties of Ga and In dually doped-ZnO thin films	14	Không	Journal of Alloys and Compounds	Q1 - ISI IF: 5.316	18	747 156-165	05/2018
17	Influence of top electrode on resistive switching effect of chitosan thin films	4	Có	Journal of Materials Research	Q1 - ISI IF: 3.089	8	34, 23, 3809-3906	12/2019
18	Resistive switching effect and magnetic properties of iron oxide nanoparticles embedded-polyvinyl alcohol film	5	Có	RSC Advances	Q1 - ISI IF: 3.361	9	10 12900-12907	03/2020

	of ZnO nanoparticles using orange fruit peel extract for antibacterial activities				3.361		23899-23907	0
20	Low operating voltage resistive random access memory based on graphene oxide-polyvinyl alcohol nanocomposite thin films	7	Có	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	Q1 - ISI IF: 6.92	3	5, 2, 199-206	06/2020
21	Multi-scale defects in ZnO thermoelectric ceramic materials co-doped with In and Ga	15	Không	Ceramics International	Q1 - ISI IF: 4.527	17	46, 6, 10748-10758	06/2020
22	Enhancing visible-light-driven water splitting of ZnO nanorods by dual synergistic effects of plasmonic Au nanoparticles and Cu dopants	6	Không	Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry	Q1 - ISI IF: 4.291	7	399 112639	06/2020
23	Dopants and induced residual stress-controlled thermoelectric properties of ZnO thin films	10	Không	Materials Science and Engineering: B	Q2 - ISI IF: 4.051	5	261 114712	11/2020
24	Effects of multi-scale defects on the thermoelectric properties of delafossite CuCrS_2	16	Không	Journal of Alloys and Compounds	Q1 - ISI IF: 5.316	7	844 156119	12/2020

	xMgxO ₂ materials							
25	Experimental combined theoretical study on chemical interactions of graphene oxide with chitosan and its resistive-switching effect	7	Có	Materials Science and Engineering: B	Q2 - ISI IF: 4.051	3	262 114788	12/2020
26	Dependence of mechanical and electrical properties on crystal orientation of CuCr _{0.95} Mg _{0.05} O ₂ ceramics	8	Không	Journal of Physics: Conference Series	Q4 - ISI IF: 0.547		2013, 1, 012008	01/2021
27	Improving memory performance of PVA:ZnO nanocomposite: The experimental and theoretical approaches	8	Có	Applied Surface Science	Q1 - ISI IF: 6.86	2	537 148000	01/2021
28	The chitosan/ZnO bio-nanocomposites with selective antibacterial efficiency	8	Có	Journal of Materials Research	Q1 - ISI IF: 3.089	5	36, 2, 508-517	01/2021
29	Abnormal volatile and normal stable bipolar resistive switching characteristics of hybrid nanocomposites : Morphology-defects-property	10	Có	Journal of Alloys and Compounds	Q1 - ISI IF: 5.316	7	875 157602	03/2021

30	The Resistive Switching Behavior of Al/Chitosan-Graphene Oxide/FTO Structure	3	Có	Journal of Nanomaterials	Q2 - ISI IF: 2.986	2	5565169	03/2021
31	C-AFM study on multi - resistive switching modes observed in metal-organic frameworks thin films	10	Có	Organic Electronics	Q1 - ISI IF: 3.7	1	93 106136	06/2021
32	Ultrasensitive biosensors based on waveguide-coupled long-range surface plasmon resonance (WC-LRSPR) for enhanced fluorescence spectroscopy	8	Không	RSC Advances	Q1 - ISI IF: 3.361		11 22450- 22460	06/2021
33	The roles of interstitial oxygen and phase compositions on the thermoelectric properties CuCr _{0.85} Mg _{0.15} O ₂ delafossite material	16	Không	Journal of Alloys and Compounds	Q1 - ISI IF: 5.316	5	867 158995	06/2021
34	Compensation of Zn substitution and secondary phase controls effective mass and weighted mobility in In	11	Không	Journal of Materiomics	Q1 - ISI IF: 7.96	7	7, 4, 742- 755	07/2021

	doped ZnO material							
35	Effect of Cation Exchange Time on the Morphology and Photoactivity of CdS/Ag ₂ S Composites for Ciprofloxacin Degradation	6	Không	Physica Status Solidi (A)	Q2 - ISI IF: 2.821		219, 7, 2100634	01/2022
36	The effect of content and thickness of chitosan thin films on resistive switching characteristics	5	Có	Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Tp.HCM, Quốc gia uy tín ISSN: 1859-0128			23, 3, 632-639	09/2020
37	The Resistive Switching Characteristics and Electrical Conduction Mechanisms of Memory Devices Based on Nanocomposite	5	Có	Tạp chí khoa học: Toán – Lý Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia uy tín, ISSN:2588-1124			37, 3	09/2021

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 11 ([15] [17] [18] [19] [20] [25] [27] [28] [29] [30] [31])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp	Tên cơ quan	Ngày tháng	Tác giả chính/	Số tác
----	--	-------------	------------	----------------	--------

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDDT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

T T	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò U/V (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
1	Ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Công nghệ vật liệu	Tham gia	3044/QĐ-KHTN, 31/12/2018	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM	447/QĐ-KHTN, 29/05/2020	N/A
2	Kiểm định chất lượng đào tạo ngành Khoa học vật liệu theo tiêu chuẩn AUN-QA	Tham gia	1805B/QĐ-KHTN-KT&ĐBCL, 14/9/2018	Asean University Network	AP578VNUH CMNOV20	N/A

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (U/V PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (U/V chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (U/V chức danh PGS) ☒

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu: C-AFM study on multi - resistive switching modes observed in metal-organic frameworks thin films, Organic Electronics, 93, 106136 (2021)

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tỉnh Đồng Tháp, ngày 20 tháng 06 năm 2022

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phan Kim Ngọc